This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

10 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−160823

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990) 6月20日

C 08 G 61/12

NLJ

8215-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

図発明の名称 導電性高分子複合体の製造方法

田

②特 顧 昭63-314970

20出 願 昭63(1988)12月15日

の発明者 岡

昌 樹

山口県徳山市大字久米347-26

@発明者 毛 利

隆

山口県新南陽市土井2丁目15-4-404

勿出 顋 人 東ソー株式会社

山口県新南陽市大字富田4560番地

PTO 99-4969

S.T.I.C. Translations Branch

明 和 书

1. 発明の名称

専電性高分子複合体の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 少なくともα位がフッ素競換されたアニオン はを有する高分子電解質を含む溶液中でチオフェン類モノマーの電解酸化血合を行なうことを 特徴とするポリチオフェン類と前記電解質の複 合体の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(選案上の利用分野)

本地明は導地性高分子複合体の製造方法に関し、詳しくは地解質のアニオン基を固定ドーパントとする、ポリチオフェン類と前記電解質の複合体を製造する方法に関するものである。

専治性高分子は、現在その新規な物理特性、電気化学特性より、導体、半導体、電池、設示場子、

光 電 変換 業 子 、 セ ン サ ー 等 の 新 し い 機 能 性 材 料 と し て 注 目 を 集 め て い る 。

(従来の技術)

イオンドーピング法によりポリアセチレンの専 電性が著しく上昇することが見出されて以来、各種のイオンドーピング型導電性高分子が提案されている。

P型財電性高分子のドーパントとしては、ハロゲンイオンのような小さなものから、巨大環状分子、さらには高分子地解質まで可能であると考えられており、専出性高分子の機能化を目的とした、各種ドーパントのドーピング方法及び得られた専出性高分子の特性と用途の開発が注目される新技術として検討されている。

上記ドーパントの一例としては無機アニオンが 挙げられる。しかしながら、後ドーパントは専選 性高分子中に多量にドープされ得るものの、均一 にドープされないという問題があり、このため得 られる高分子は専選性の点で満足できるものでは ない。更にこの高分子は自立性が悪く、脆いという欠点を有する。

このことから、近年アニオン話を有する高分子 **化解質をドーパントとすることが提案されており、** 例えば特別昭59-98165号公報ではポリマ - をドーパントとする遊出性ポリマー組成物が恐 案されている。この組成物は、ポリマードープ剤 として、スルホン化ポリエチレン。スルホン化ポ リスチレン, スルホン化ポリ(2,5-ジメチルフェ ニレンオキシド)、スルホン化ポリピニルアルコ - ル、スルホン化スチレン/(水煮化)プタジエ ンコポリマー等が挙げられており、アニオン茲は スルホン酸基より形成されている。この提案は、 従来の無機アニオンをドーパントとする導電性高 分子に比べて、安定で自立性の導電性高分子複合 体が得られることを示したものであり注目される ものである。しかしながら、導電性材料としては 化学的、物理的安定性等の面で必ずしも十分なも のではなく、またイオンドーパント型導電性高分 子の重要な要素であるドーピング率は、片面にお

・も満足できるものではなく、得られる膜にはドーパントが不均一にドーピングされるという問題である。また化学重合法を用いて合成した専選性高分子と高分子能解質の複合体は、ドーパントを移動するドーパントと移動するドーパントともつ、専党性高分子と高分子で解質の複合膜が形成されるようになる。

いて海電性高分子の過度が大きく、他の片面において高分子地解質過度が大きくなるため、一般の無機アニオンドーパントを用いる場合と比較して低いものであるという問題がある。更に本発明者らの検討によると、このスルホン化ポリマードーブ側のスルホン酸基は、水溶液中では解離するが、非水溶媒中での解離は困難である場合が多く、従って、この導性をことが困難であり、実用化への一つの障壁となっている。

子地解質が25%程度しかドーピングされて全です。マニオンは解質の子地解質の子地解質の子地解質のアニオンはのでは、マニオンが理度であることにより、複合体は、アニオンがなる。では、アニオンの方面を使いている。では、アニオンの方面を使いている。では、アニオンの方面を使いている。では、アニオンの方面を使いている。では、アニオンの方面をできまった。では、アニオンの方面をできまった。では、アニオンのでは、アニオールのでは、アニオンのでは、アニオン・アニオンは、アニオンは、アニオンは、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンは、アニオンが、アニオンが、アニオンは、アニオンが、アニオンが、アニオンが、アニオンは、アニオンが、アニオンは、アニオンは、アニオンは、アニオンが、アニオンは、ア

以上述べたとおり、従来提案されているアニオンなを有する地解質、特に高分子地解質と専習性高分子との複合体においては、高分子地解質のドープ率は通常の無機アニオンで報告されているドーパント率よりは低い値のものである。また、高分子地解質のアニオン基とその他の無機アニオンとの調査がドーピングされる場合が多く、従って、間定されたドーパントと移動するドーパントと

世合ドーバント型と考えられる。更に得られた膜は必ずしも均一組成なものではなく、物理的、化学的安定性が不十分な場合もあり、また各種溶媒中で十分に機能しないなどの問題点もある。

(発明が解決しようとする課題)

作い専定性高分子内外を移動することができないものである。そのため、このような固定ドーパント型の専定性高分子においては、酸化還元に伴い、専定性高分子内に固定されたアニオンの対イオン、即ちカチオンが専定性高分子内を出入りするようになる。このように、固定ドーパント型専定性高分子とは、明確に異なるレドックス模構を示すものである。

 (課題を解決するための手段)

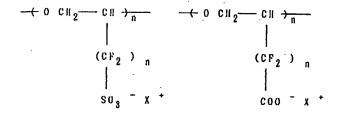
本範明者らは上記問題点を解決するために鋭意 検討を行なった結果、電解酸化重合法により 個別 体を製造することにより 個いドープ 単を示す 間定 ドーパント型の 専電性 高分子が得られることを発明 は、少なくとも a 位がフッ 紫霞 投されたアニオン 基を行する高分子 世解 飲む 溶液中でチオフェ とするポリチオフェン 類と前記世解質の複合体の 製造方法である。

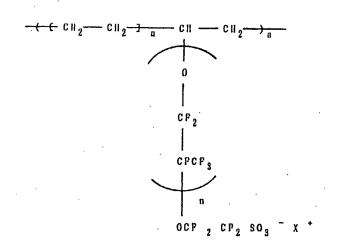
以下、本発明を具体的に説明する。

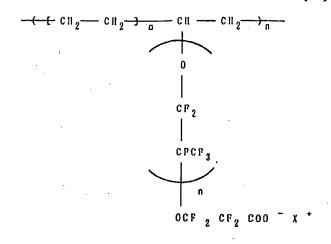
第1図に本発明における固定ドーバント型進伐 性高分子のレドックスモデルを示す。無機アニオンをドーパントとする一般の移動ドーパント型連 伐性高分子は、第2図に示すとおり酸化還元に伴いドーパントであるアニオンが堪伐性高分子内を 出人りするものである。一方、固定ドーパント 遊出性高分子は、第1図に示すとおりドーパント が事代性高分子内に固定されており、酸化還元に

中はもちろん非水溶液など各種溶媒中でも規能できるようになる。この理由は明らかではないが、本発明で用いられる電解質は、非水溶媒中でもフッ次の有する電子受容性によりアニオン基を解離することができるためと考えられる。

上記 電解質の具体例としては、以下の構造のオリゴマーまたはポリマーを挙げることができる。







更に具体的には、下記の構造を有するテトラフルオロエチレンとパーフルオロー3、6ージオキサーメチルー7ーオクテンスルファミン酸との共 近合体を含む高分子社解質を挙げることができる。

電解酸化型合に川いる溶液は、可溶性溶媒中に 同記電解質を溶解することにより得られ、可溶性 溶媒としては、極性溶媒例えば、アルコール類、 ケトン類、 有极酸類、アルデヒド類、エステル類 等を挙げることができる。 溶液の凝皮は特に限定 されないが、 電解質が 10⁻³ col/de³ 以上の設度の 溶液であることが好ましい。

また本発明において用いられるチオフェン類とは、チオフェンあるいはチオフェン誘導体であり、特に、誘導体は導出性高分子の構造上、3位及び/又は4位に置換基を行する誘導体であることが好ましい。誘導体としては例えば3ーメチルチオフェン、3ーメトキシチオフェン等を挙げることができる。

世解放化重合は、隔極反応により実施されるが、 陽極としては、例えば白金等の金属、表面に1T 〇等の専電性物質を被覆した導電性硝子やグラッシーカーボン等の任意の導電性基体を用いること ができる。

世解 般化 血合の条件としては、定電流 選解法.

定出位化解法,バルス化解法、代位走查 化解法等 を川いることができる。例えば、定化流 化解法 を行なう場合、チオフェン類を含む 化解質の溶液液 を川いて、10⁻² mA/cd~10¹ mA/cdの定 電流 で 後 に は か で きる。また、定 能 位 電 解 法 を 存 な う 場合、チオフェン 類 を 含む 世 解 質 の溶液 を 存 液 を 川いて、チオフェン 類 の 酸 化 電 位 以 上 の 粒 位、例えば + 1.5~ + 2.5 V vs SCE の 電 位 を 関 極 に 印 加 し 地 解 酸 化 重 合 を 行 な う こ と に よ り ず 他 性 高 分 子 複 合 体 を 得 る こ と が で きる。

世解酸化正合を行う際の溶液温度は、目的とする時世間分子複合体の性質により適宜調整されるが、高いドーブル、物理的、化学的安定性、均一な組成安定性を備えた時間性高分子複合体を得るためには、溶液温度を塑温以下に保つことが望ましい。

以上のように得られた、専電性高分子複合体は、 電解質のアニオン基のみをドーパントとする間定 ドーパント型あり、ドーパントのドープ単はポリ チオフェン類1ユニットあたり 0. 15~0. 3 となる。これは無機ハロゲンアニオンと同程度に高いアニオン基のドープ串である。更に、得られる専出性高分子複合体は、物理的、化学的安定性にも優れた均一な組成で、かつ各種溶媒中でも機能し得るものとなる。

本発明の製造方法により得られる固定ドーバント型導電性高分子は、移動するイオンが、固定アニオンの対イオンであるカチオンとなるため、延気化学素子への適用、例えば二次電池の正極として別さな特性を持つものであり、例えばリチウムであるに極として川いた場合は、移動種が正極、負極同一となり、地解質温度が変化しない代池を形成することができる。

(尖施例)

以下、実施例を述べるが、本発明はこれらに限 定されるものではない。

尖陷例1,比较例1

次に得られた導電性為分子複合体を試験極に、対極に白金板、参照電極に飽和カロメル電極用いて、塩化カリウムを1 ao1/da³ 含む水溶液中でサイクリクボルタンメトリーを行った。その結果をポリス第 3 図の実験に示す。また、同様な測定をポリスチレンスルホン般ソーダ(分子量:10000)の20重量%水溶液中で行った。その結果を第 4 図の実験に示す。

 白金プレート(有効化極面積 0.5 cd)を関極に川い、チオフェンを 0.01 mol/dm³ 含んだテトラフルオロエチレンとパーフルオロー 3.6 ージオキサーメチルー 7 ーオクテンスルファミン酸の共血合体を含む化解質(デュポン社製 ナフィオン)のアルコール溶液(短解質5 低量%,水10 重量%を含有する)を川いて、 0.5 mA/ cdの定地流で 0.6 C/ cdまで B 極限化 重合を行い、ポリチオフェンと 世解質との導電性高分子 後合体を 得られた 導電性高分子 複合体 に、 はりチオフェンと 世界質との 導電性高分子 後合体 に、 はりチオフェンと 世界質との 導電性高分子 後合体を 得られた 導電性高分子 後った。

得られた導電性高分子複合体の元素分析を行ない、各構成元素の複合体の中に占める割合から複合体の相成を算出したところ、この導電性高分子複合体中には、ポリチオフェン1 aol に対して電解質が 0.25 aol 含まれていることがわかった。また EPMA分析によって、得られた導電性高分子複合体の深さ方向の範環子の分布を調べたところ、磁質原子は均一に分散していた。

にポリスチレンスルホン酸ソーダ水溶液・中では、 レドックスが認められてない。これは、単独ニオンが出入りするスプに作いアニオンがは入りするススなポリ合った。 お助ホン酸アニオンがオンとなる場合できないできないことを示す。これに対けてニオンがないに対けていたができないがあります。これに対係の大きないがある。 3 図及の年4 図からかなように、時保無に対象ないが増入した。 の可逆には、アニオンをかけてはないがは、これのではは、アニオルタモのではは、アニオルタモのははないのではよりにはよりにはないがある。

更に、この専宅性高分子複合体の酸化還元に伴う移動イオンの同定をEPMA分析によって行った。 その結果を第5図ー a に示す。また、比較例1に示す。第5図ー b から、単独体では酸化量元に伴いCIO4 イオンが増減することから、単独的ではではないのでは変更のでは、単独のでは酸化還元に伴いカリウムイオンが増減する。これに対し第5図ー a から、専電性高分子複合体では酸化還元に伴いカリウムイオンが増減する

ることから、得られた専地性高分子複合体は、カチオン移動のレドックスを示すことが確認された。 更に、ポリチオフェン中の確立とドーパントである地解質のアニオン基の硫黄が、酸化還元により 変化していないことから、ドーパントである選解 質のアニオン基は、固定ドーパントとして機能し ていることがわかった。

实施例2

金板、参照世極に飽和カロメル 用極用いて、過塩 本後リチウムを 1 mol/do 8 含む 規酸プロピレン中でサイクリクボルタンメトリーを行ったところ、容 は 近合 電気 量から 見積った レドックス 容 昼 の 5 % であった。 これは、ドーパントであるポリスチレンスルホン酸アニオンの非水溶液中での 解離が 困難であるため、十分な容量が得られないものと 推察される。

比较例3

チオフェン18gとテトラフルオロエチレンとパーフルオロー3.6ージオキサーメチルー7ーオクテンスルファミン酸の共近合体を含む形解質(デュポン社型 ナフィオン177)7gを用いて、これにドーパント及び重合 焙煙 重合 成 した。 得 の 大 で し な は 自 立 性 の と の な 合 成 し た。 得 られ た 複 合 体 は 自 立 性 の フィルム 状 の も の で は な け が れ れ の も の で、 仮 合 体 の 元 紫 分 折 の 粘 果 か ら ポリチオフェン中に は 世 質 が 2 0 重 量 % 含まれ て

チオフェンのかわりに3ーメチルチオフェンを 川いた以外は、実施例1と同様の方法で、専電性 高分子複合体を作製し評価を行った。その結果、 得られた専地性高分子複合体は、物理的、化学的 に安定な自立性のフィルムで、0.2~5のドープ 半で均一に複合化しており、電気化学的評価 思さ カチオン移動型のレドックスを示すことが確認さ れた。さらに、過塩紫酸リチウムを1 mol/dn³ 含 む炭酸プロピレン中で95%のレドックス容量が 得られた。

比较例2

自金ブレート(有効地極面積 0 . 5 cd)を陽極に川い、地解液としてチオフェン 0 . 1 aoi/da 8 とポリスチレンスルホン酸カリウム 2 0 g とを含む水溶液を川いて、 0 . 5 cM/cdの定地流で 0 . 6 C / cdまで陽極酸化低合を行い、ポリチオフェンとポリスチレンスルホン酸との導電性高分子複合体を得た。

この専出性高分子複合体を試験極に、対極に白

いることがわかった。この結果から、得られた複合体のドープ単は、 0 . 0 2 であることがわかった。

得られた複合体の粉末をペレット状に加圧形成したものを試験値に用いて実施例と同じ評価を行ったところ、酸化還元に伴う移動イオンは、カチオン、アニオンの両方であった。これは、化学重合で得られる複合体のドープ率及び均一性に問題があるためと推察される。

(発明の効果)

以上述べたとおり、本発明によれば無极ハロゲンアニオンと同程度に高いアニオン悲のドープ率を示し、さらに、物理的、化学的安定性にも優れた均一な組成で、かつ各種溶媒中でも概能し得る複合体が得られる。

更に得られた複合体は、固定ドーパント型 (カチオン移動型) という新規な機能を有しており、各種の専電性高分子の用途分野おいて、注目されるものである。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明で得られる固定ドーパント型導電性高分子のレドックスモデルを示す図である。

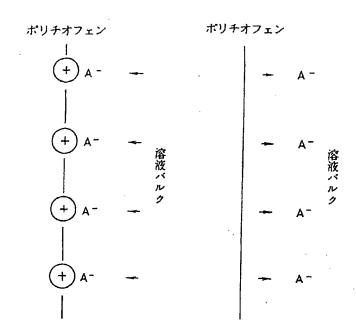
第2回は移動ドーパント型専化性高分子のレドックスモデルを示す図である。

第3図は実施例1及び比較例1で得られた専用性高分子複合体、専用性高分子の塩化カリウム水溶液中でのサイクリックボルタモグラムを示す図である。

第4図は実施例1及び比較例1で得られた専用 性高分子複合体、専電性高分子のポリスチレンス ルホン酸ソーダ水溶液中でのサイクリックポルタ モグラムを示す図である。

第5図は実施例1及び比較例1で得られた導電性高分子複合体、導電性高分子のEPMA分析の結果を示す図である。

第 2 図



特許出願人 泉ソー株式会社

第一区

